



Les modules MOSFET SiC Toshiba permettent de réduire la taille des dispositifs industriels tout en augmentant leur rendement énergétique

Düsseldorf, Allemagne, 17 mars 2021 – Toshiba Electronics Europe ("Toshiba") s'appuie sur son expertise technologique dans les procédés de semi-conducteurs à large bande interdite (WBG) pour présenter un module MOSFET compact mais doté d'un haut rendement.

Le nouveau MG800FXF2YMS3 intègre deux canaux MOSFET au carbure de silicium (SiC), présentant une tension nominale de 3 300 V et capables de supporter des courants de 800 A. Les principales applications de ces modules à haute densité de puissance sont notamment les variateurs de vitesse industriels et les commandes moteur, les onduleurs de puissance destinés aux sites de production d'énergie renouvelable, ainsi que les convertisseurs inverseurs utilisés dans les infrastructures ferroviaires électriques.

La technologie de boîtier exclusive de Toshiba est essentielle à l'obtention des performances élevées de ces nouveaux modules MOSFET SiC. Les boîtiers iXPLV (intelligent fleXible Package Low Voltage) auxquels font appel ces modules reposent sur une technologie avancée de liaison interne par argent fritté pour obtenir les niveaux de rendement opérationnel atteints. La température des canaux peut atteindre 175°C, tandis que l'isolement est assuré jusqu'à 6 000 Veff. Les pertes de commutation à l'allumage et à l'extinction sont limitées à 250 mJ et 240 mJ respectivement, avec une valeur d'inductance parasite typique de 12 nH seulement.

Pour plus d'informations, merci de visiter :

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfet-modules/detail.MG800FXF2YMS3.html>

###

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. En dehors des disques durs, le large portefeuille de la société comprend des semiconducteurs de puissance et d'autres dispositifs discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques, des semiconducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à certaines applications (ASSP), entre autres.

TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, avec des filiales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant le marketing, les ventes et des services logistiques. Le président de la société est M. Tomoaki Kumagai.

Pour plus d'informations sur la société, visitez le site web de TEE sur www.toshiba.semicon-storage.com.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0 Fax : +49 (0) 211 5296 79197

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Email : solution-marketing@toshiba-components.com

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0) 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 1582 390980

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Mars 2021

Ref. 7326_FRE